

SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGH GAIN
MEDIUM POWER TRANSISTOR

FMMTL619

ISSUE 2 – NOVEMBER 2005

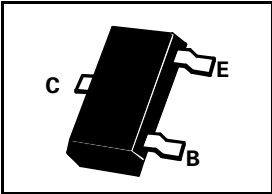
FEATURES

Very low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)}=160m\Omega$ at 1.25A

COMPLEMENTARY TYPE – FMMTL720

PARTMARKING DETAIL – L69

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.



PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	I_C	1.25	A
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Base Current	I_B	200	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

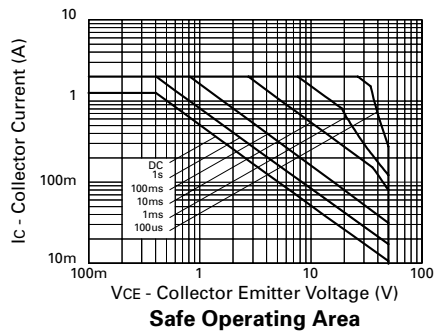
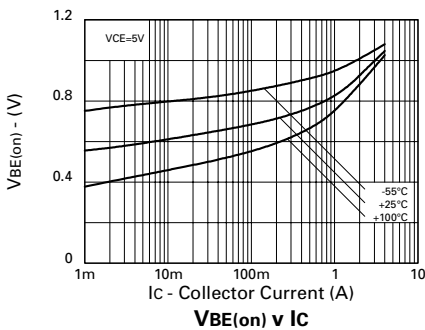
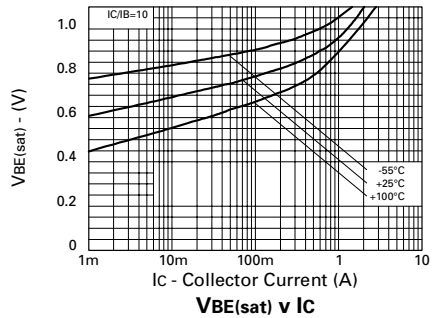
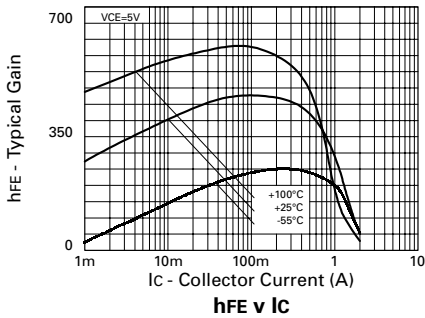
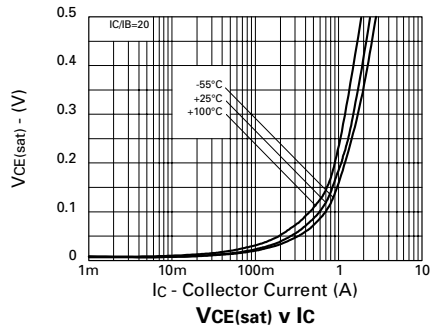
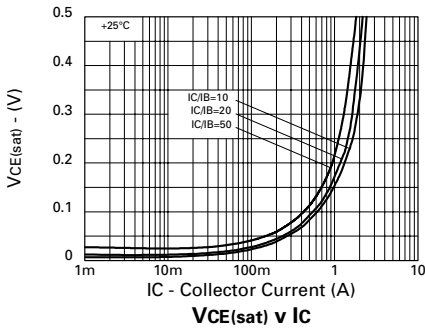
FMMTL619

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	100	210		V	$I_C = 100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	50	70		V	$I_C = 5\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	8.5		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			10	nA	$V_{CB} = 40\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			10	nA	$V_{EB} = 4\text{V}$
Collector Cut-Off Current	I_{CES}			10	nA	$V_{CE} = 40\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		24 60 100 195	45 100 180 330	mV mV mV mV	$I_C = 100\text{mA}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 250\text{mA}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 500\text{mA}, I_B = 25\text{mA}^*$ $I_C = 1.25\text{A}, I_B = 125\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1020	1100	mV	$I_C = 1.25\text{A}, I_B = 125\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$		895	1000	mV	$I_C = 1.25\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	200 300 200 100 30	400 450 400 230 50			$I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 200\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}^*$ $I_C = 500\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}^*$ $I_C = 1\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}^*$ $I_C = 2\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		180		MHz	$I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Collector-Base Breakdown Voltage	C_{obo}		6	8	pF	$V_{CB} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Switching times	t_{on} t_{off}		182 379		ns ns	$I_C = 1\text{A}, V_{CC} = 10\text{V}$ $I_{B1} = -I_{B2} = 10\text{mA}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9